

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 075 168 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
07.02.2001 Bulletin 2001/06

(51) Int Cl. 7: H05H 1/46

(21) Numéro de dépôt: 00420172.9

(22) Date de dépôt: 02.08.2000

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 04.08.1999 FR 9910291

(71) Demandeur: METAL PROCESS,
Société à Responsabilité Limiteé:
77144 Montevrain (FR)

(72) Inventeurs:
• Lagarde, Thierry
38450 Vif (FR)
• Pelletier, Jacques
38400 Saint Martin d'Heres (FR)

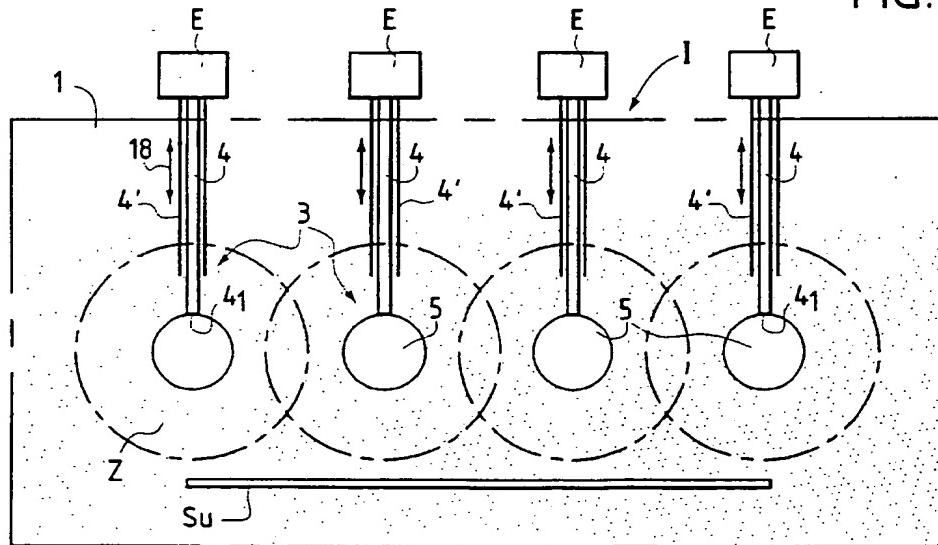
(74) Mandataire: Thibault, Jean-Marc
Cabinet Beau de Loménie
51, Avenue Jean Jaurès
B.P. 7073
69301 Lyon Cédex 07 (FR)

(54) Procédé de production de plasmas élémentaires en vue de créer un plasma uniforme pour une surface d'utilisation et dispositif de production d'un tel plasma

(57) L'objet de l'invention concerne un dispositif comprenant une série de dispositifs élémentaires d'excitation de plasma (3), constitués chacun par un applicateur filaire (4) d'une énergie micro-onde, dont une extrémité est reliée à la source de production (E) et dont l'autre extrémité est équipée en tant que moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique, d'au moins un dipôle magnétique

(5) monté à l'extrémité (4₁) de l'applicateur micro-ondes, de manière à assurer l'oscillation entre les pôles des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique, en vue de créer une zone de diffusion (Z) de plasma située à l'opposé de l'extrémité (4₁) de l'applicateur par rapport audit dipôle, les dispositifs élémentaires d'excitation (3) étant répartis entre eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation (S_u), en vue de créer ensemble un plasma uniforme pour la surface d'utilisation.

FIG.1



Description

[0001] La présente invention concerne le domaine technique général de la production de plasma à basse pression excité par une énergie micro-onde dans le domaine de la résonance cyclotronique électronique.

[0002] L'objet de l'invention concerne toutes les applications nécessitant une uniformité de plasma contrôlable sur des grandes surfaces présentant un caractère plan ou courbe.

[0003] La présente invention concerne des applications très diverses, telles que les traitements de surface, comme la gravure, le dépôt, le traitement chimique ou thermochimique, la pulvérisation, le nettoyage, la désinfection, la décontamination ou la production de faisceaux d'ions obtenus par extraction du plasma.

[0004] Dans le domaine de la technique d'excitation d'un plasma à la résonance cyclotronique électronique, la résonance est obtenue lorsque la fréquence de giration d'un électron dans un champ magnétique statique ou quasi statique est égale à la fréquence du champ électrique accélérateur appliqué. Cette résonance est obtenue pour un champ magnétique **B** et une fréquence d'excitation **f** liée par la relation :

$$B = 2\pi m f / e$$

où **m** et **e** sont la masse et la charge de l'électron.

[0005] Dans le cas de l'excitation d'un plasma, la résonance cyclotronique électronique est efficace uniquement si l'électron est suffisamment accéléré, c'est-à-dire si l'électron peut tourner suffisamment longtemps en phase avec le champ électrique pour acquérir l'énergie de seuil nécessaire à l'ionisation du gaz. Pour satisfaire cette condition, il faut, d'une part, que le rayon de giration de l'électron soit suffisamment petit, en particulier, pour rester dans la région de l'espace réunissant les conditions de résonance c'est-à-dire la présence simultanée du champ électrique et du champ magnétique et, d'autre part, que la fréquence de giration **f** reste grande devant la fréquence de collision des électrons sur les éléments neutres, tels que les atomes et/ou les molécules. Autrement dit, les meilleures conditions d'excitation d'un plasma à la résonance cyclotronique électronique sont obtenues à la fois pour une pression de gaz relativement faible et une fréquence **f** de champ électrique élevée, c'est-à-dire aussi pour une intensité de champ magnétique **B** élevée.

[0006] Le brevet français n° 85 08 836 décrit une technique d'excitation de plasma à la résonance cyclotronique électronique nécessitant la mise en oeuvre d'aimants permanents créant chacun au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique. L'énergie micro-onde est amenée au niveau de la zone de résonance par l'intermédiaire d'antennes ou d'excitateurs de plasma constitués chacun par un élément fi-

laire métallique. Chaque exciteur s'étend à proximité et le long d'un aimant en étant disposé au droit d'un aimant permanent.

[0007] Le champ magnétique d'intensité égale à la valeur donnant la résonance et le champ électrique micro-onde sont tous les deux localisés et confinés essentiellement dans l'espace situé entre un exciteur et la partie de la paroi de l'enceinte placée en regard d'un aimant. En présence d'un milieu gazeux présentant une pression réduite, les électrons sont accélérés dans la zone de résonance et s'enroulent le long des lignes de champ magnétique qui définissent une surface de confinement du plasma. Ces lignes de champ en forme de festons relient le pôle d'un aimant à son pôle opposé ou au pôle opposé d'un aimant consécutif. Le long de son trajet, l'électron dissocie et ionise les molécules et les atomes avec lesquels il entre en collision. Le plasma ainsi formé dans les festons de champ magnétique diffuse ensuite, à partir des lignes de champ, pour former un plasma pratiquement exempt des électrons énergétiques qui restent piégés dans les festons.

[0008] L'inconvénient majeur de la technique décrite par ce brevet a trait au fait que la zone de propagation de l'énergie micro-onde et la zone de résonance où l'énergie micro-onde est absorbée se superposent. La propagation des micro-ondes ne peut donc s'effectuer qu'avec des pertes et l'intensité du champ électrique micro-onde et la densité du plasma diminuent tous deux progressivement le long de l'exciteur à partir de la source micro-onde. Le plasma obtenu présente une densité non uniforme le long de l'exciteur, de sorte qu'un tel plasma apparaît inadapté à la plupart des applications industrielles.

[0009] Une variante de la technique décrite ci-dessus fait l'objet du brevet français n° 93 02 414. Selon cette technique, les micro-ondes sont appliquées directement à l'une des extrémités de l'applicateur de champ magnétique constitué par des aimants permanents ou par un conducteur parcouru par un courant électrique. Cette fois encore, les micro-ondes se propagent principalement dans la zone de résonance cyclotronique électronique et subissent donc une forte atténuation, ce qui conduit à la production d'un plasma non uniforme le long de l'aimant. L'intérêt de cette solution par rapport à la technique précédente est, d'une part, la simplification du dispositif et, d'autre part, une efficacité accrue de l'excitation du plasma, dans la mesure où l'intensité du champ magnétique et l'intensité du champ électrique micro-onde sont toutes les deux maximums à la surface de l'applicateur.

[0010] Afin de remédier au défaut d'uniformité du plasma lié à la propagation d'une onde progressive fortement atténuée, le brevet français n° 91 00 894 propose d'exciter le plasma à l'aide d'une onde stationnaire d'amplitude constante. A cet effet, il est proposé de faire propager les micro-ondes dans une zone distincte de celle où les conditions de résonance cyclotronique électronique sont remplies. La solution proposée est d'ap-

pliquer la puissance micro-onde à l'aide d'un applicateur filaire situé non pas en face des pôles des aimants, mais à mi-distance de deux pôles opposés voisins dans la zone interdite au plasma. Ainsi, il est possible d'obtenir un plasma uniforme le long des aimants, les maxima et les minima de champs micro-ondes dus à l'onde stationnaire le long des aimants étant "gommés" par la vitesse de dérive des électrons le long des aimants, perpendiculairement au plan du champ magnétique.

[0011] La généralisation de l'utilisation d'ondes stationnaires pour exciter des plasmas uniformes à la résonance cyclotronique électronique est proposée dans le brevet français n° 94 13 499 où l'établissement des ondes stationnaires est contrôlé par l'adjonction de propagateurs linaires auprès de l'applicateur des micro-ondes disposés en dehors de la zone d'absorption des micro-ondes à la résonance cyclotronique électronique. [0012] Toutefois les techniques décrites par ces brevets n° 91 00 894 et n° 94 13 499 où la propagation des micro-ondes s'effectue sous forme d'ondes stationnaires présentent la difficulté d'obtenir une amplitude constante notamment pour une longueur relativement importante de l'applicateur micro-ondes. En outre, l'ajustement de l'uniformité et de l'amplitude impose généralement d'utiliser une adaptation d'impédance en amont de l'applicateur micro-ondes.

[0013] L'analyse des différentes techniques de l'art antérieur conduit à constater des défauts d'uniformité du champ électrique et du plasma le long des applicateurs, dus à la très forte atténuation du champ électrique par absorption résonante de la puissance micro-onde par les électrons à la résonance cyclotronique électronique. Autrement dit, les techniques décrites ci-dessus ne permettent pas de produire un plasma uniforme sur de grandes longueurs et donc sur de grandes surfaces typiquement, sur des dimensions de l'ordre du mètre ou supérieur. En outre, ces techniques présentent un inconvénient majeur, à savoir le rayonnement des micro-ondes à partir des applicateurs et des propagateurs, dû au confinement médiocre de la puissance micro-onde dans la zone de propagation. Il en résulte des couplages entre les applicateurs particulièrement néfastes pour l'obtention de bonnes uniformités de plasma. Un autre inconvénient réside dans la difficulté de réaliser et d'introduire dans une enceinte sous vide des applicateurs ou des propagateurs non rectilignes. Il en résulte une quasi impossibilité de traiter de façon uniforme des surfaces courbes.

[0014] L'objet de l'invention vise donc à remédier aux inconvénients des techniques antérieures en proposant un procédé permettant de produire un plasma uniforme en relation d'une surface d'utilisation de dimensions relativement importants.

[0015] Un autre objet de l'invention est d'offrir un procédé de production d'un plasma uniforme en relation d'une surface d'utilisation de forme plane ou courbe.

[0016] Pour atteindre les divers objectifs énoncés ci-dessus, l'objet de l'invention concerne un procédé de

production d'un plasma pour une surface d'utilisation, à l'aide d'un dispositif comportant des moyens de production d'une énergie dans le domaine des micro-ondes et des moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique et placée au moins dans la zone de propagation des micro-ondes, en vue de l'excitation du plasma.

[0017] Selon l'invention, le procédé consiste :

- à constituer une série de dispositifs élémentaires d'excitation de plasma constitués chacun par un applicateur d'une énergie micro-onde dont une extrémité est reliée à une source de production d'une énergie micro-onde et dont l'autre extrémité est équipée d'au moins un dipôle magnétique en tant que moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique,
- à monter le dipôle magnétique à l'extrémité de l'applicateur micro-ondes, de manière à assurer l'oscillation entre les pôles des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique, en vue de créer une zone de diffusion de plasma située au moins à l'opposé de l'extrémité de l'applicateur, par rapport audit dipôle,
- et à répartir les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma entre eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation, de manière à obtenir au moins une juxtaposition entre les plasmas produits par chaque dispositif élémentaire, en vue de créer un plasma uniforme pour la surface d'utilisation.

[0018] Un autre objet de l'invention vise à proposer un dispositif de production d'un plasma en relation d'une surface d'utilisation, le dispositif comportant des moyens de production d'une énergie dans le domaine des micro-ondes, et des moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique et placée au moins dans la zone de propagation des micro-ondes, en vue de l'excitation du plasma.

[0019] Selon l'invention, le dispositif comprend une série de dispositifs élémentaires d'excitation de plasma, constitués chacun par un applicateur filaire d'une énergie micro-onde dont une extrémité est reliée à la source de production et dont l'autre extrémité est équipée, en tant que moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique, d'au moins un dipôle magnétique monté à l'extrémité de l'applicateur micro-ondes, de manière à assurer l'oscillation entre les pôles des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique, en vue de créer une zone de diffusion de plasma située à l'opposé de l'extrémité de l'applicateur par rapport audit dipôle, les dispositifs élémentaires d'excitation étant répartis entre eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation, en vue

de créer ensemble un plasma uniforme pour la surface d'utilisation.

[0020] Diverses autres caractéristiques ressortent de la description faite ci-dessous en référence aux dessins annexés qui montrent, à titre d'exemples non limitatifs, des formes de réalisation et de mise en oeuvre de l'objet de l'invention.

[0021] La fig. 1 est une vue schématique en élévation permettant d'illustrer un dispositif de production d'un plasma conforme à l'invention.

[0022] La fig. 2 est une vue de dessus montrant un exemple de réalisation d'un dispositif de production d'un plasma conforme à l'invention.

[0023] Les fig. 3 à 8 illustrent diverses variantes de réalisation d'un dispositif élémentaire d'excitation de plasma faisant partie d'un dispositif de production conforme à l'invention.

[0024] Les fig. 9 et 10 sont des schémas illustrant divers montages des dispositifs élémentaires d'excitation entre eux.

[0025] Les fig. 1 et 2 illustrent, à titre d'exemple, un dispositif I de production d'un plasma en relation d'une surface d'utilisation au sens général S_u , pouvant constituer, par exemple, une surface susceptible de recevoir différents traitements de surface. Le dispositif I comprend, de façon classique une enceinte étanche 1 représentée à titre schématique, équipée de dispositifs d'introduction de gaz et de pompage de gaz, non représentés mais connus en soit, permettant de maintenir la pression du gaz à ioniser à une valeur souhaitée qui peut être par exemple de l'ordre de 10^{-3} à quelques dizaines de Pascals suivant la nature du gaz et la fréquence d'excitation.

[0026] Conformément à l'invention, le dispositif de production I comporte une série de dispositifs 3 élémentaires d'excitation de plasma répartis entre eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation S_u , en vue de créer ensemble un plasma uniforme pour cette surface d'utilisation S_u . Conformément à l'invention, chaque dispositif élémentaire 3 d'excitation de plasma est constitué par un applicateur d'une énergie micro-onde 4 réalisé sous une forme filaire, c'est-à-dire allongée. L'applicateur filaire 4 est raccordé à l'une des ses extrémités, de préférence, par une structure coaxiale 4', à une source d'énergie E dans le domaine des micro-ondes, extérieure à l'enceinte 1. Chaque applicateur filaire 4 se trouve réalisé avantageusement sous la forme d'un tube entouré d'un tube coaxial 4' permettant ainsi la propagation de l'énergie micro-onde jusqu'à son extrémité libre 4₁ en évitant le rayonnement des micro-ondes et le couplage des micro-ondes entre les applicateurs.

[0027] Selon une autre caractéristique de l'invention illustrée plus précisément à la fig. 3, chaque applicateur micro-onde 4 est destiné à être relié par son extrémité 4₁ opposée à celle reliée à la source d'énergie micro-onde E, à au moins un dipôle magnétique 5 adapté pour créer au moins une surface 6 à champ magnétique et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique

électronique. Dans l'exemple de réalisation illustré à la fig. 3, le dipôle magnétique 5 est constitué par un aimant permanent de forme sphérique, dont la direction d'aimantation A et la position des pôles nord N et sud S

5 par rapport au point d'application des micro-ondes, à savoir l'extrémité 4₁ de l'applicateur, sont quelconques. Cet aimant permanent 5 crée ainsi une surface 6 autour de la sphère correspondant à la condition de résonance cyclotronique électronique, tandis que les lignes 7 10 représentent les lignes de champ magnétique qui joignent les deux pôles opposés de l'aimant et qui convergent à ces pôles. Entre deux collisions, les électrons accélérés au niveau de la zone de résonance 6 par le champ électrique micro-onde appliquée par l'applicateur filaire 2, oscillent entre le pôle nord et le pôle sud et entre les lignes 15 de champ 7. De façon avantageuse, ces électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique oscillent entre des points miroirs P₁, P₂ situés à proximité et face à chaque pôle, et présentent une même intensité 20 de champ magnétique, conformément à la théorie décrite dans le livre intitulé "MICROWAVE EXCITED PLASMA", chap. 12, page 368 édité par M. MOISAN et J. PELLETIER, ELSEVIER, Amsterdam (1992). Ces électrons subissent aussi un mouvement de dérive 25 autour de l'axe d'aimantation de l'aimant, ces dérives magnétiques étant dues à la courbure et au gradient du champ magnétique. Le plasma produit par ces électrons le long de leur trajectoire, diffuse ensuite à l'extérieur de la zone source sous l'influence, des gradients de densité du plasma. Il apparaît ainsi une zone Z de diffusion 30 de plasma située au moins à l'opposé, par rapport au dipôle 5, de l'extrémité 4₁ de l'applicateur.

[0028] Dans l'exemple de réalisation illustré à la fig. 3, il doit être constaté qu'une partie au moins des trajectoires électroniques rencontre l'applicateur filaire 4, de sorte qu'une partie des électrons se trouve collectée par cet applicateur filaire 4, de sorte qu'il apparaît une perte pour les électrons.

[0029] Pour éviter cette perte d'électrons, il peut être prévu, comme illustré à la fig. 4, de placer le dipôle magnétique 5 de manière que son axe d'aimantation A se trouve situé sensiblement parallèlement à l'axe de l'applicateur filaire. De préférence, l'axe d'aimantation A du dipôle magnétique 5 est situé sensiblement dans le prolongement de l'axe de l'applicateur filaire 4. Selon cet exemple, les trajectoires électroniques ne rencontrent plus l'applicateur filaire 4 et les électrons peuvent poursuivre leur trajectoire sans obstacle entre deux collisions élastiques ou inélastiques. Dans ce type de fonctionnement, il est ainsi obtenu une structure magnétique tridimensionnelle de type magnétron où les électrons peuvent osciller et dériver indéfiniment sans se perdre sur des parois. En réalité, les électrons rapides ou primaires, accélérés par résonance cyclotronique électronique, perdent inévitablement de l'énergie en produisant le plasma et deviennent des électrons lents ou thermiques contribuant ainsi en partie à la population électronique du plasma.

[0030] Selon les exemples de réalisation illustrés aux fig. 3 et 4, les aimants permanents 5 sont représentés en ayant une forme sphérique. En fait, dans le cas de l'invention, la forme des aimants importe peu et ceux-ci peuvent être de forme quelconque voire complexe (anneaux, tore, parallélépipède, etc) et présenter des aimantations très variées (par exemple axiale, diamétrale ou radiale). Toutefois, ces aimants 5 doivent présenter une aimantation suffisante pour générer la condition de résonance cyclotronique électronique. En outre, comme dans le cas des aimants sphériques, il est préférable que ces aimants puissent constituer une structure de type magnétron dans laquelle l'application des micro-ondes n'entraîne pas de perte d'électrons.

[0031] Selon une solution préférée de réalisation illustrée à la fig. 5, chaque dipôle 5 est constitué par un aimant de forme cylindrique présentant une aimantation axiale A qui se trouve sensiblement située dans le prolongement de l'axe de l'applicateur filaire 4. L'un des pôles de l'aimant délimité par une surface transversale 5₁, est destiné à être en contact avec l'extrémité 4₁ de l'applicateur pour permettre l'application des micro-ondes. Il est ainsi obtenu une structure magnétique de type magnétron à symétrie de révolution. Selon cet exemple de réalisation, il est à noter que certaines lignes de champ 7 viennent converger au niveau du pôle situé à l'extrémité 4₁ de l'applicateur, en rencontrant ledit applicateur filaire 4, ce qui entraîne encore des pertes d'électrons significatives.

[0032] Pour éviter un tel inconvénient, il peut être prévu de réaliser un aimant 5 cylindrique d'aimantation axiale et comportant un alésage central 8 suivant l'axe de l'aimant. Selon cet exemple de réalisation illustré à la fig. 6, une partie 7' des lignes de champ magnétique passe désormais dans l'alésage central 8 de l'aimant. En outre, les pôles magnétiques ne sont plus ponctuels mais décrivent des cercles centrés sur l'axe de révolution de l'aimant vers lesquels les lignes de champ magnétique 7 et 7' convergent. Aussi, si le diamètre de l'enveloppe externe de l'applicateur 4 est égal au diamètre du cercle décrit par le pôle magnétique, les électrons accélérés par la résonance cyclotronique électronique ne peuvent pas décrire de trajectoires s'appuyant sur les lignes de champ 7'. Il apparaît ainsi que l'extrémité 4₁ de l'applicateur filaire ne franchit pas le pôle magnétique. Les seules lignes de champ utiles sont donc les lignes de champ 7 extérieures à l'aimant et, par conséquent, aucune trajectoire électronique ne rencontre l'applicateur filaire 4 entre deux points miroirs P₁, P₂. Il n'apparaît donc pas de perte d'électrons et il peut être ainsi obtenu des performances optimales en termes de rendement énergétique.

[0033] Selon cette caractéristique préférée de réalisation, chaque alésage axial 8 peut être utilisé pour permettre le montage d'une canalisation 9 d'aménée d'un fluide de refroidissement et servant avantageusement de support de montage pour l'aimant 5. Cette canalisation 9 réalisée sous la forme d'un tube communiquant, à

son extrémité, avec une enceinte 11 délimitée entre l'aimant et une enveloppe 12 entourant à distance l'aimant. L'enceinte 11 débouche dans une conduite 13 de retour du fluide de refroidissement délimitée entre la canalisation d'aménée 9 et l'applicateur filaire 4 constitué par un tube. L'aimant 4 se trouve ainsi encapsulé par l'enveloppe de protection 12 permettant la circulation d'un fluide de refroidissement autour de l'aimant. Par exemple, le matériau d'encapsulation de l'aimant et celui constituant les applicateurs filaires 4 sont réalisés en matériau amagnétique bon conducteur (métaux non magnétiques), mais ils peuvent également être entourés, pour des raisons de contamination, par des matériaux diélectriques sans nuire au bon fonctionnement du dispositif.

[0034] Selon une autre caractéristique possible de réalisation, il est à noter qu'il peut être envisagé d'équiper chaque dipôle magnétique 5 d'une conduite 14 d'aménée d'un gaz traversant le dipôle magnétique par son alésage axial 8. Par exemple, la conduite 14 est montée à l'intérieur de la canalisation d'aménée 9 pour déboucher à l'extrémité opposée de l'enveloppe 12.

[0035] La fig. 7 illustre une autre variante de réalisation dans laquelle chaque dipôle magnétique 5 présente une face polaire délimitée par un matériau à haute perméabilité magnétique 15, tel que par exemple une plaquette de fer doux sur laquelle est montée l'extrémité 4₁ de l'applicateur filaire 4. Un tel dipôle magnétique 5 est constitué pour présenter des pôles magnétiques adjacents. Ainsi, tel que cela apparaît sur la fig. 7, il peut être obtenu, à partir d'aimants concentriques accolés nord/sud montés alternativement de manière opposée, des lignes de champ 7 s'établissant entre deux pôles adjacents consécutifs situés sur une face polaire opposée à la face polaire constituée par la plaquette 15.

[0036] La fig. 8 illustre une variante de réalisation à celle décrite à la fig. 7. Selon cette variante, le dipôle magnétique 5 présente une face polaire délimitée par la plaquette 15 sur laquelle est montée l'extrémité 4₁ de l'applicateur filaire 4. Le dipôle 5 est constitué par un aimant à aimantation axiale prolongeant l'axe de l'applicateur filaire 4. Dans cette configuration, les électrons sont accélérés à la résonance cyclotronique électronique à partir des lignes correspondantes 6 et oscillent entre deux points miroirs P₁, P₂. L'un P₁ des points n'est plus situé en face du pôle de l'aimant mais sur le côté, le long de l'applicateur filaire 4, tandis que l'autre point P₂ reste en face du pôle. Ainsi, la présence de la plaquette 15 disposée au-delà de l'extrémité 4₁ de l'applicateur filaire, permet de modifier la position spatiale des points miroirs P₁, P₂ associés aux pôles de chaque dipôle magnétique 5. Ces deux exemples de réalisation décrits aux fig. 7 et 8, ne sont pas limitatifs des autres positions relatives du ou des matériaux 15 par rapport à la configuration des aimants 5.

[0037] Tel que cela découle directement de la description qui précède, le procédé selon l'invention consiste donc à constituer une série de dispositifs élémentaires

d'excitation de plasma 3 permettant de créer chacun au moins une surface 6 à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique. Un dipôle magnétique 5 est monté à l'extrême de l'applicateur micro-ondes, de manière à assurer l'oscillation des électrons entre les pôles, en vue de créer une zone de diffusion de plasma Z située au moins à l'opposé de l'extrême 4₁ de l'applicateur par rapport au dipôle. Ensuite, il est prévu de répartir les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma 3 entre eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation S_u, de manière à obtenir au moins une juxtaposition entre les plasmas produits par chaque dispositif élémentaire en vue de créer un plasma uniforme pour la surface d'utilisation. Il doit être compris que les plasmas élémentaires produits par les dispositifs 3 se recouvrent ou se chevauchent au moins en partie, afin d'obtenir un plasma uniforme pour la surface d'utilisation S_u.

[0038] Selon une caractéristique préférée de réalisation, il est prévu de régler la distance entre les dispositifs élémentaires d'excitation 3 et la surface d'utilisation S_u, afin d'ajuster l'excitation de plasma au profil de la surface d'utilisation. Ainsi tel que cela ressort plus précisément des fig. 1 et 9, chaque dispositif élémentaire d'excitation de plasma 3 comporte des moyens 18 de réglage du déplacement axial de l'applicateur filaire 4, de manière à régler la distance de chaque dispositif élémentaire 3 par rapport à la surface à traiter S_u. Il peut ainsi être obtenu une disposition relative des dispositifs s'adaptant au mieux aux profils des surfaces à traiter, par exemple courbe. De plus, la puissance de l'énergie micro-onde de chaque dispositif élémentaire d'excitation 3 peut être réglée, en vue d'adapter l'uniformité du plasma.

[0039] Dans l'exemple de réalisation illustré à la fig. 9, les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma 3 sont répartis de manière que les dipôles magnétiques 5 possèdent des axes d'aimantation orientés dans un même sens. Il peut ainsi être obtenu à une distance éloignée des dipôles 5, un champ magnétique faiblement divergent et dont l'intensité décroît lentement.

[0040] Dans l'exemple illustré à la fig. 10, il est prévu de répartir les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma 3, de manière que les dipôles magnétiques 5 possèdent des axes d'aimantation alternativement orientés d'un dispositif voisin à un autre. Il est ainsi obtenu une structure multipolaire classique avec une décroissance rapide, quasi exponentielle, de l'intensité du champ magnétique en fonction de l'éloignement par rapport aux aimants.

[0041] D'après la description qui précède, l'objet de l'invention permet d'obtenir une uniformité de plasma ne dépendant pas des conditions de propagation des micro-ondes et offre la possibilité de traiter des surfaces d'utilisation de grandes dimensions.

[0042] Les principaux domaines d'applications de l'invention sont le traitement uniforme (nettoyage, dépôt, gravure, etc) des surfaces de grandes dimensions, pla-

nes ou gauches. A titre d'exemple, pour la fabrication des circuits intégrés, il est possible d'effectuer des traitements de surface sur des plaquettes de silicium de diamètre 300 mm en utilisant un réseau de 32 sources

5 élémentaires espacées entre elles de 60 mm (fig. 2). Les aimants cylindriques, en samarium-cobalt (Sm-Co), ont 20 mm de diamètre et 30 mm de long et sont réalisés selon l'exemple illustré à la fig. 6. Le plasma est excité à la résonance cyclotronique électronique par des micro-ondes à 2,45 GHz, la condition de résonance ($B_0 = 0,0875$ tesla) étant largement remplie par les aimants permanents utilisés. Pour tous les types de procédé développés, l'uniformité obtenue est meilleure que $\pm 5\%$. [0043] L'invention n'est pas limitée aux exemples décrits et représentés, car diverses modifications peuvent y être apportées sans sortir de son cadre.

Revendications

- 20 1. Procédé de production d'un plasma pour une surface d'utilisation (S_u) à l'aide d'un dispositif comportant des moyens de production d'une énergie dans le domaine des micro-ondes et des moyens pour créer au moins une surface (6) à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique et placée au moins dans la zone de propagation des micro-ondes, en vue de l'excitation du plasma, caractérisé en ce qu'il consiste :
 - à constituer une série de dispositifs élémentaires d'excitation de plasma (3) constitués chacun par un applicateur filaire (4) d'une énergie micro-onde dont une extrémité est reliée à une source de production (E) d'une énergie micro-onde et dont l'autre extrémité est équipée d'au moins un dipôle magnétique (5) en tant que moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique,
 - à monter le dipôle magnétique (5) à l'extrême (4₁) de l'applicateur micro-ondes (4), de manière à assurer l'oscillation entre les pôles des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique, en vue de créer une zone de diffusion (Z) de plasma située au moins à l'opposé de l'extrême de l'applicateur, par rapport au dipôle,
 - et à répartir les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma (3) entre-eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation (S_u), de manière à obtenir au moins une juxtaposition entre les plasmas produits par chaque dispositif élémentaire (3), en vue de créer un plasma uniforme pour la surface d'utilisation.
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à régler la distance entre les dispositifs élémentaires d'excitation (3) et la surface d'utilisation (S_u), afin d'ajuster l'excitation de plasma au profil de la surface d'utilisation.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il consiste à régler la puissance de l'énergie micro-onde de chaque dispositif élémentaire d'excitation (3), en vue de régler l'uniformité du plasma.
4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à répartir les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma (3), de manière que les dipôles magnétiques (5) possèdent des axes d'aimantation orientés dans un même sens.
5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à répartir les dispositifs élémentaires d'excitation de plasma (3), de manière que les dipôles magnétiques (5) possèdent des axes d'aimantation alternativement orientés d'un dispositif voisin à un autre.
6. Dispositif de production d'un plasma pour une surface d'utilisation (S_u), le dispositif comportant des moyens de production d'une énergie dans le domaine des micro-ondes, et des moyens pour créer au moins une surface (6) à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique et placée au moins en relation de la zone de propagation des micro-ondes, en vue de l'excitation du plasma,
caractérisé en ce qu'il comprend une série de dispositifs élémentaires d'excitation de plasma (3), constitués chacun par un applicateur filaire (4) d'une énergie micro-onde, dont une extrémité est reliée à la source de production (E) et dont l'autre extrémité est équipée en tant que moyens pour créer au moins une surface à champ magnétique constant et d'intensité correspondant à la résonance cyclotronique électronique, d'au moins un dipôle magnétique (5) monté à l'extrémité (4_1) de l'applicateur micro-ondes, de manière à assurer l'oscillation entre les pôles des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique, en vue de créer une zone de diffusion (Z) de plasma située à l'opposé de l'extrémité (4_1) de l'applicateur par rapport au dipôle, les dispositifs élémentaires d'excitation (3) étant répartis entre eux et en relation de proximité de la surface d'utilisation (S_u), en vue de créer ensemble un plasma uniforme pour la surface d'utilisation.
7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que chaque dispositif élémentaire d'excitation (3) comporte au moins un dipôle magnétique (5)
- 5 dont l'axe d'aimantation (A) est situé sensiblement parallèlement à l'axe de l'applicateur filaire (4).
8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que chaque dipôle magnétique (5) comporte au moins un matériau (15) à haute perméabilité magnétique, placé au-delà de l'extrémité (4_1) de l'applicateur filaire, de manière à modifier la position de points miroirs (P_1, P_2) associés à chaque pôle d'un dipôle magnétique et entre lesquels oscillent des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique.
- 10 9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que chaque dipôle magnétique (5) est constitué par un cylindre aimanté axialement et dans lequel est aménagé un alésage axial (8) et en ce que le diamètre de l'applicateur filaire (4) est égal au diamètre du cercle décrit par le pôle magnétique, en vue d'éviter qu'il coupe les trajectoires des électrons accélérés à la résonance cyclotronique électronique.
- 15 10. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que chaque dipôle magnétique (5) est pourvu d'une canalisation (9) d'aménage d'un fluide de refroidissement montée dans un alésage axial et communiquant avec une enceinte (11) enveloppant le dipôle magnétique et débouchant dans une conduite de retour (13) du fluide de refroidissement.
- 20 11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que la canalisation de retour (13) du fluide de refroidissement est délimitée entre la canalisation d'aménage (9) et un tube (4) formant l'applicateur filaire.
- 25 12. Dispositif selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que chaque dipôle magnétique (5) est équipé d'une conduite d'aménage de gaz (14) traversant le dipôle magnétique par son alésage axial (8).
- 30 13. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 12, caractérisé en ce que chaque dispositif élémentaire de production (3) est équipé de moyens de déplacement axial permettant de régler la distance entre la surface d'utilisation (S_u) et le dipôle magnétique (5).
- 35 14. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 13, caractérisé en ce que chaque applicateur filaire (4) est relié par une structure coaxiale (4'), à une source d'énergie (E) dans le domaine des micro-ondes, extérieure à l'enceinte (1).
- 40
- 45
- 50
- 55

FIG.1

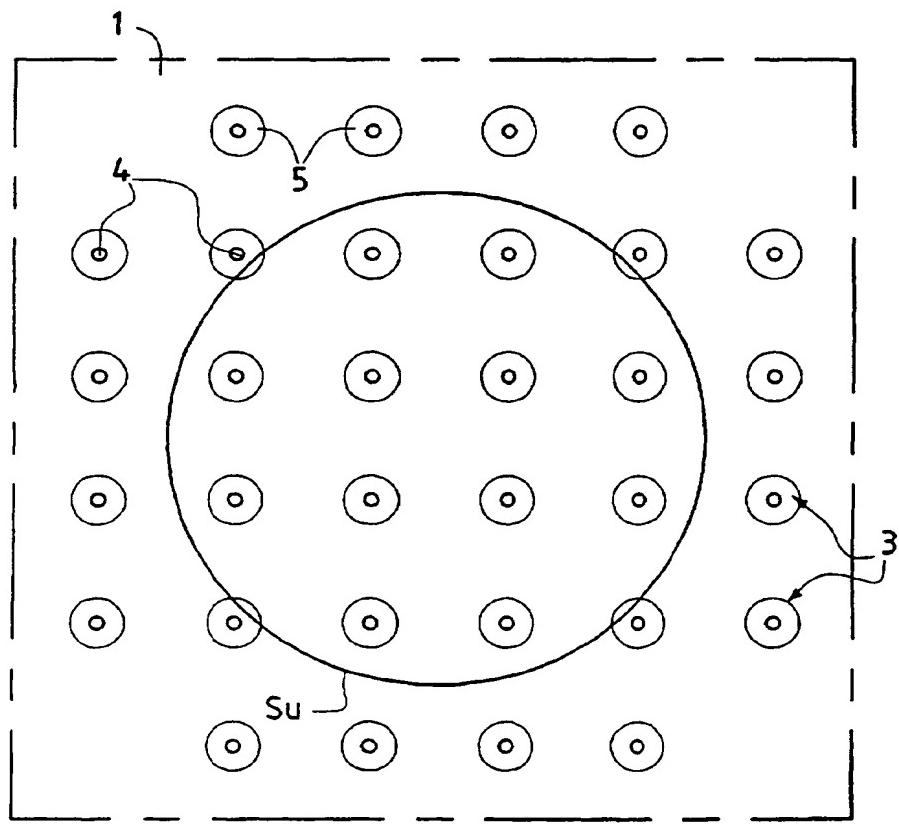
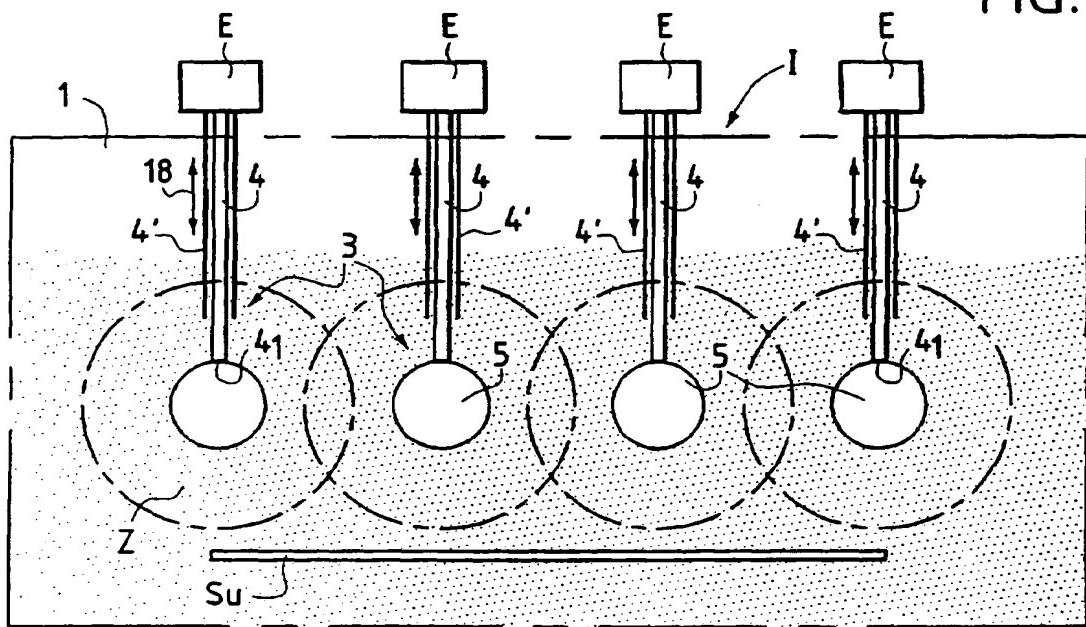


FIG.3

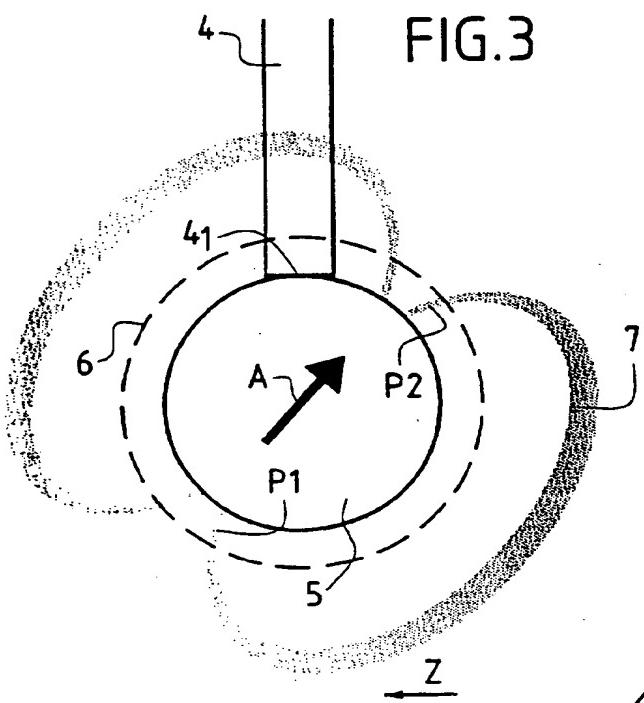


FIG.4

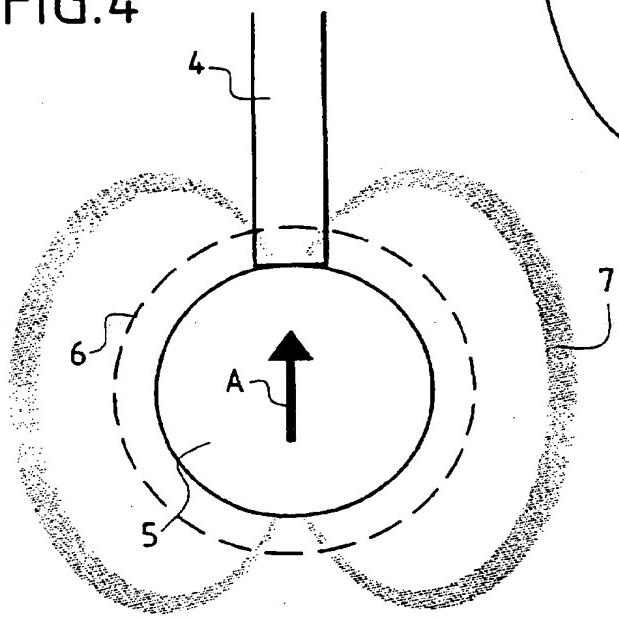
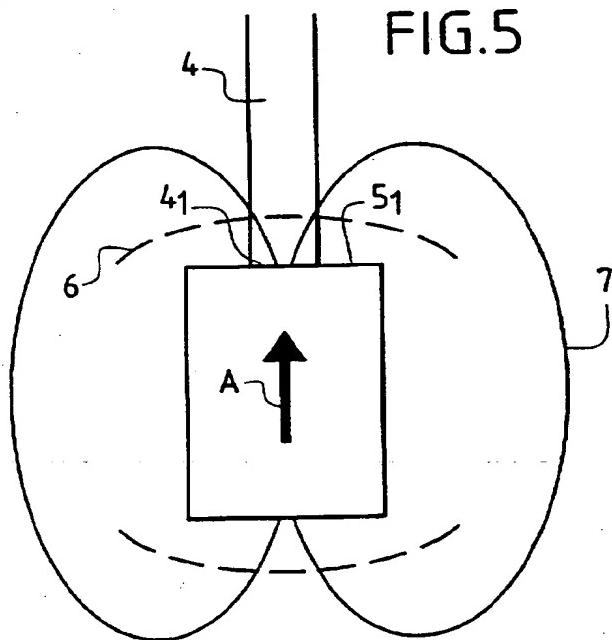


FIG.5



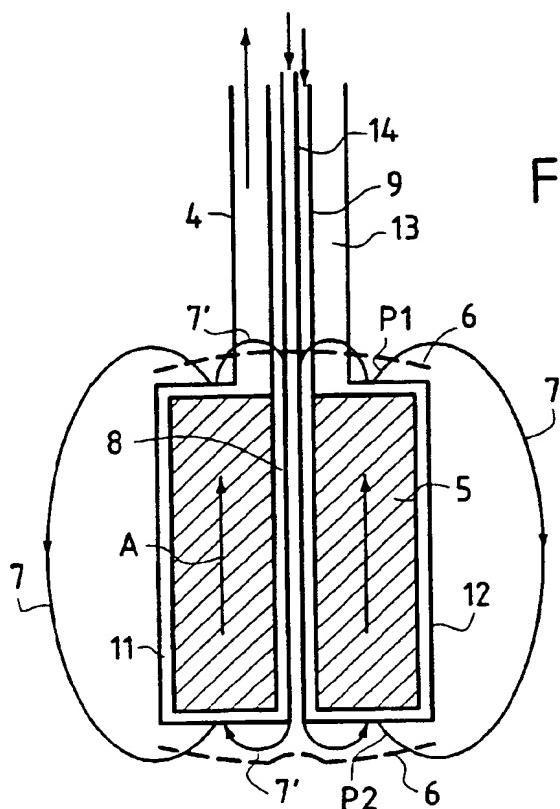


FIG.6

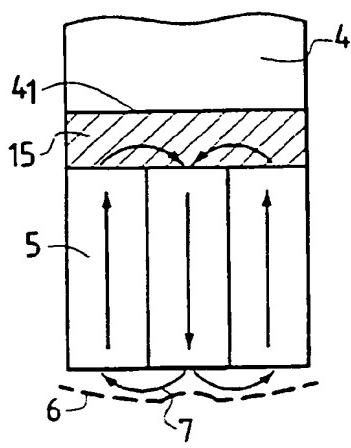


FIG.7

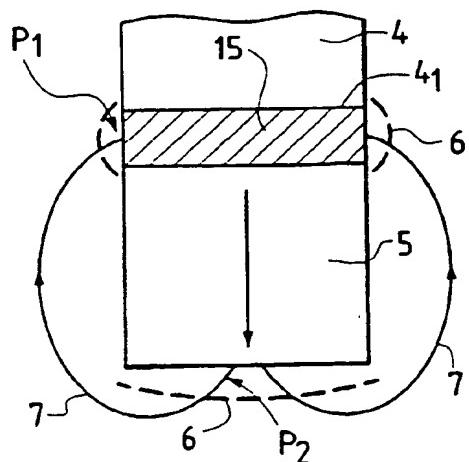
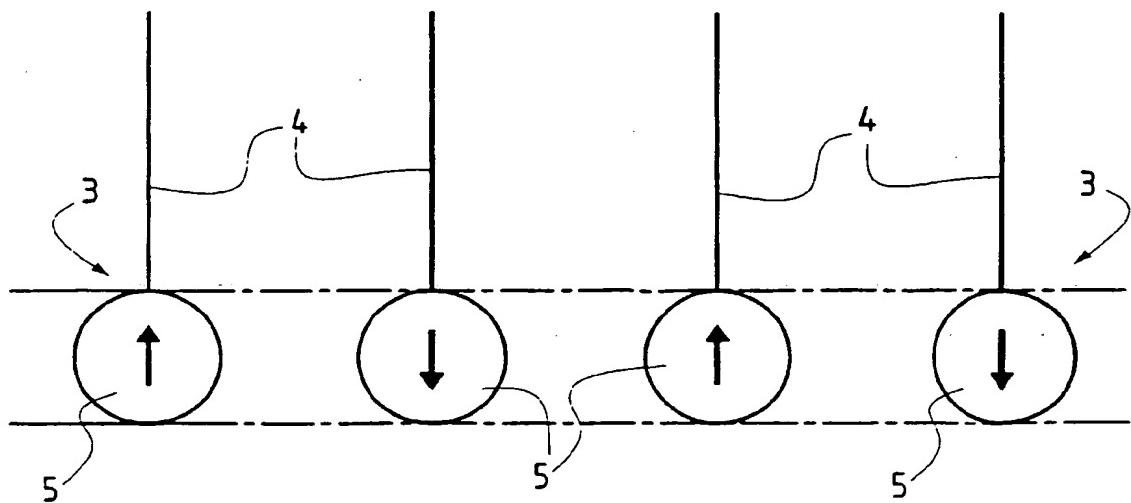
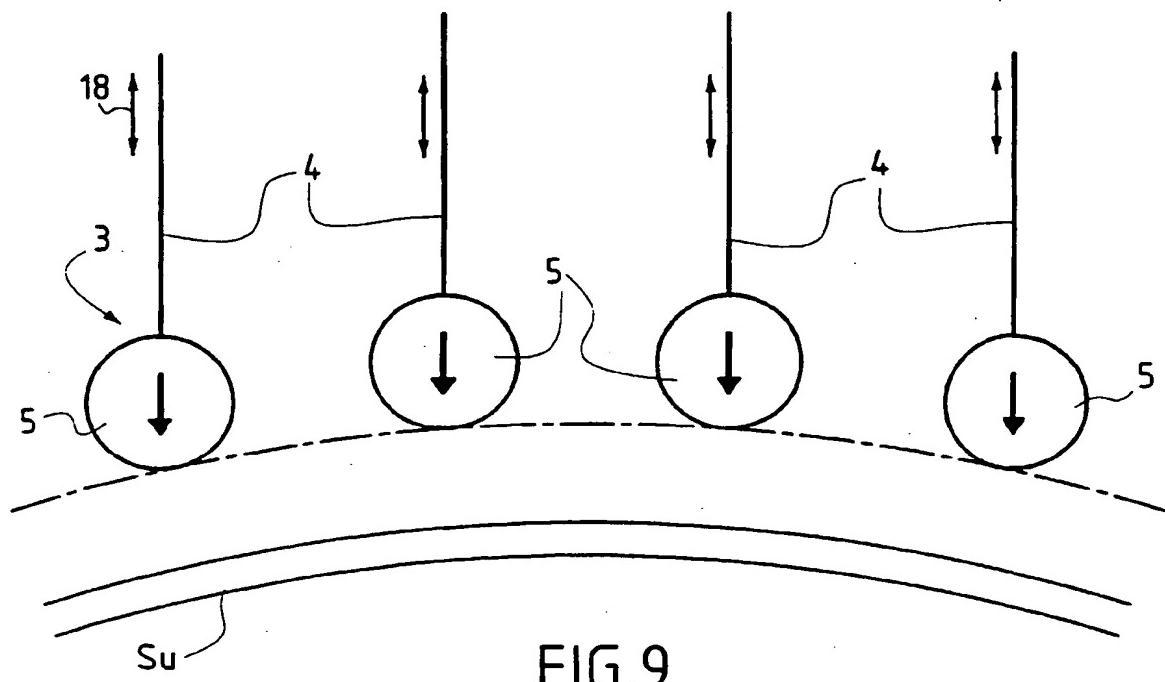


FIG.8





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 00 42 0172

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Categorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
Y	US 5 180 948 A (HEINEMANN MICHAEL ET AL) 19 janvier 1993 (1993-01-19) * colonne 4, ligne 2 - ligne 15 * * colonne 4, ligne 46 - ligne 67 * * colonne 5, ligne 35 - ligne 55 * * figures 1A,2,3C-4B *	1,2, 6-11,13	H05H1/46
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 116 (E-1515), 24 février 1994 (1994-02-24) & JP 05 314918 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 26 novembre 1993 (1993-11-26) * abrégé *	1,2, 6-11,13	
A	US 4 473 736 A (BLOYET EMILE ET AL) 25 septembre 1984 (1984-09-25) * colonne 4, ligne 56 - ligne 66 * * figure 1 *	3	
D,A	EP 0 613 329 A (METAL PROCESS SARL) 31 août 1994 (1994-08-31) * le document en entier *	1,4-6	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
D,A	EP 0 711 100 A (METAL PROCESS SARL) 8 mai 1996 (1996-05-08) * colonne 8, ligne 29 - ligne 32 *	12	H05H
A	US 5 844 217 A (ASMUSSEN JR JES ET AL) 1 décembre 1998 (1998-12-01) * colonne 2, ligne 36 - ligne 49 * * figure 2 *	14	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche	Examinateur	
LA HAYE	31 octobre 2000	Capostagno, E	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul	T : théorie ou principe à la base de l'invention		
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie	E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date		
A : amière-plan technologique	D : cité dans la demande		
O : divulgation non-écrite	L : cité pour d'autres raisons		
P : document intercalaire	& : membre de la même famille, document correspondant		

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 42 0172

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

31-10-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5180948 A	19-01-1993	DE 9102438 U EP 0501466 A JP 5082290 A	25-06-1992 02-09-1992 02-04-1993
JP 05314918 A	26-11-1993	AUCUN	
US 4473736 A	25-09-1984	FR 2480552 A CA 1177543 A DE 3162741 D EP 0043740 A JP 1595356 C JP 2019600 B JP 57005299 A US 4609808 A	16-10-1981 06-11-1984 26-04-1984 13-01-1982 27-12-1990 02-05-1990 12-01-1982 02-09-1986
EP 0613329 A	31-08-1994	FR 2702119 A JP 6290898 A US 5536914 A	02-09-1994 18-10-1994 16-07-1996
EP 0711100 A	08-05-1996	FR 2726729 A DE 69507261 D DE 69507261 T JP 8279400 A US 5666023 A	10-05-1996 25-02-1999 17-06-1999 22-10-1996 09-09-1997
US 5844217 A	01-12-1998	IIS 5770143 A	23-06-1998

FORM P050

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)